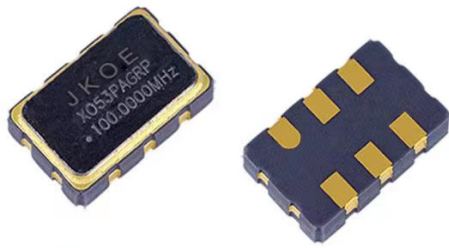


XO53P/ XO53L/ XO53H



产品特点及应用范围:

- LVPECL、LVDS、HCSL 输出
- 体积小
- 盘带包装
- 无铅环保产品
- 可靠性高
- SDH
- 高速信号处理
- 万兆接入设备
- PCIE 总线

产品性能

性能参数		条件	XO53P	XO53L	XO53H
频率范围(MHz)	F ₀		10.000 ~ 800.000		13.50~200.0
标称频率(MHz)	F ₀		106.25, 125, 155.52, 156.25, 200		
频率准确度	F _{tol}	AT 25℃	≤±25 ppm		
工作温度范围	T _{OPR}		见下表		
工作电压	V _{DD}		A: +3.3VDC±5%; D: +2.5VDC±5%		
工作电流	I _{DD}	10M≤F ₀ <80M	75mA Max.	50mA Max.	30mA Max.
		80M≤F ₀ <160M	100mA Max.	50mA Max.	40mA Max.
		160M≤F ₀ ≤800M	100mA Max.	65mA Max.	50mA Max.
输出波形	Output Wave		P: LVPECL	L: LVDS	H: HCSL
输出负载	Output Load		50Ω	100Ω	50Ω
待机电流	Stand-by Consumption		30μA Max.		
抖动	RMS Jitter	12KHz~20MHz	1.0pS typ. (3pS Max.)		
输出对称性	SYM	50% Waveform	40%~60%		
上升/下降时间	T _r /T _f	20%~80% waveform	1 ns Max.	0.8 ns Max.	0.8 ns Max.
输出电平	"0"电平 V _{OL}		(V _{DD} -1.620)V Max	0.9V Min.	0.15V Max.
	"1"电平 V _{OH}		(V _{DD} -1.025)V Min	1.6V Max.	0.4VMin
启动时间	T _s		3mS Max.		
老化率	F _{age}	25℃±3℃	±5×10 ⁻⁶ /年 Max.		
储存温度范围	T _{stg}		-55℃~+125℃		

频率温度稳定度选型表

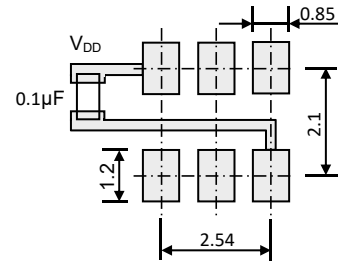
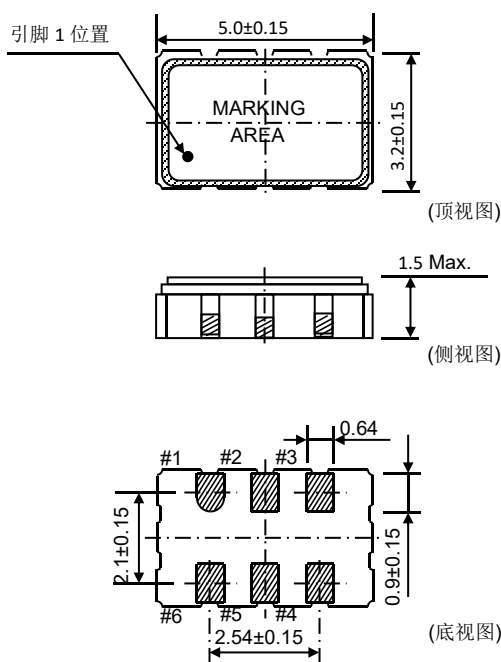
工作温度范围	频率稳定度			
	Q: ±20×10 ⁻⁶	R: ±25×10 ⁻⁶	T: ±50×10 ⁻⁶	U: ±100×10 ⁻⁶
B: -10℃ ~ +60℃	●	●	●	●
C: -20℃ ~ +70℃	●	●	●	●
ΔG: -40℃ ~ +85℃		●	●	●
▽Q: -40℃ ~ +125℃			●	●

●: 可选产品 Δ: 工业级 ▽: 汽车级

注: 频率温度稳定度选型表选型表中未标注的需与我方沟通确认

XO53P/ XO53L/ XO53H

外形尺寸 (mm)



引脚	功能	引脚	功能
#1	三态端	#4	正向输出
#2	悬空	#5	反向输出
#3	接地	#6	电源

三态功能说明	
#1	#4 #5
高电平 (70%V _{DD} Min.) 或开路	有输出
低电平 (30%V _{DD} Max.) 或接地	无输出

选型指南

产品类别	XO	53P/53L/53H	A	C	T	P	106.250	MHz
XO= 晶体振荡器								
封装尺寸		53P= 5.0×3.2×1.5mm(LVPECL) 53L= 5.0×3.2×1.5mm(LVDS) 53H= 5.0×3.2×1.5mm(HCSL)						
供电电压			A= +3.3V D= +2.5V	工作温度范围				频率温度稳定度
				B= -10°C~+60°C C= -20°C~+70°C G= -40°C~+85°C Q= -40°C~+125°C				Q= ±20×10 ⁻⁶ R= ±25×10 ⁻⁶ T= ±50×10 ⁻⁶ U= ±100×10 ⁻⁶ 详见频率温度稳定度 选型表 “●◎”为可选
								输出波形
								P= LVPECL L= LVDS H= HCSL
								频率
								10MHz~800.00MHz

选型范例

XO53P-ACTP-106.250MHz	晶体振荡器 / +3.3VDC / -20°C~+70°C / ±50×10 ⁻⁶ / LVPECL / 106.250MHz
XO53L-DGUL-156.250MHz	晶体振荡器 / +2.5VDC / -40°C~+85°C / ±100×10 ⁻⁶ / LVDS / 156.250MHz
XO53H-AGRH-100.000MHz	晶体振荡器 / +3.3VDC / -40°C~+85°C / ±100×10 ⁻⁶ / HCSL / 100.000MHz